

О МЕХАНИЗМЕ ГЕНЕРАЦИИ В ИМПУЛЬСНЫХ ОКГ НА ЭЛЕКТРОННЫХ ПЕРЕХОДАХ МОЛЕКУЛ

Л.Н. Туницкий, Е.М. Черкасов

1. Формирование дугового разряда низкого давления в трубках осуществляется в несколько стадий. Начальные стадии рассмотрены в¹. Завершающая стадия — переход от тлеющего разряда к дуговому исследовалась в². Она может быть разделена на стадию потенциальных волн и стадию нарастания тока. В настоящей работе исследуется стадия нарастания тока, которая важна для понимания процессов создания инверсии в импульсных газовых лазерах.

Стадия нарастания тока начинается с момента прихода фронта обратной волны потенциала и ионизации к катоду и характеризуется перенапряжением на трубке — напряжение на трубке оказывается больше, чем в стационарном режиме. Переход к стационарному режиму осуществляется путём увеличения разрядного тока, приводящего к перераспределению падения напряжения в цепи.

Принципиальных различий в процессах, протекающих при формировании стационарного дугового разряда и импульсного разряда, не имеется. Однако в последнем случае для стабилизации разряда также существенна разрядка ёмкости, что приводит к неустойчивости стационарного режима и прекращению разряда.

Рассмотрим ход плотности n_e и температуры T_e электронов при импульсном разряде. Для упрощения расчётов предположим, что напряжённость поля E , n_e и

T_e вдоль трубки не изменяются. Согласно², это предположение строго не соблюдается. Поэтому фактически будут определяться эффективные значения n_e и T_e .

При сделанных предположениях, исходя из условия квазинейтральности плазмы, и считая, что ионы и электроны, попадая на стенку, рекомбинируют, можно написать:

$$\frac{\partial n_e}{\partial t} = D_a(T_e) \left\{ \frac{\partial^2 n_e}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial n_e}{\partial r} \right\} + Z(T_e) n_e \quad (1)$$

при граничном условии $r = R$, $n_e = 0$ (1a)

и начальном условии $t = 0$, $n_e = n_0$ (1б)

В (1) $D_a(T_e)$ - коэффициент амбиполярной диффузии, $Z(T_e)$ - скорость ионизации и R - радиус трубки.

Ищем решение (1) в виде:

$$n_e = u(r, t) \exp \left[\int_0^t Z dt \right] \quad (2)$$

Подставляя (2) в (1) получим:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D_a \left\{ \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} \right\} \quad (3)$$

$$t = 0, u(r, 0) = n_0 \quad (3a)$$

$$r = R, u(r, t) = 0 \quad (3б)$$

Решение (3), удовлетворяющее граничному условию (3б), для больших времён ($t > R^2/D_a$) имеет вид

$$u = A \exp \left\{ - \int_0^t \left(\frac{2,4}{R} \right)^2 D_a dt \right\} J_0 \left(\frac{2,4}{R} r \right), \quad (4)$$

где A - постоянная и J_0 - функция Бесселя нулевого порядка. Согласно (2)

$$n_e = A \exp \left\{ \int_0^t \left[Z - \left(\frac{z_0}{R} \right)^2 D_a \right] dt \right\} J_0 \left(\frac{z_0}{R} r \right) \quad (5)$$

и

$$\frac{\partial n_e}{\partial t} = \left\{ Z - \left(\frac{z_0}{R} \right)^2 D_a \right\} n_e. \quad (6)$$

Для малых времён ($t \ll R^2/D_a$) можно положить $r - R = x$, перейти от (3) к одномерному уравнению диффузии и рассмотреть его решение для бесконечного полупространства.

Решение одномерного уравнения диффузии

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D_a \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (7)$$

при начальном условии $t = 0$, $x < 0$, $u(x, 0) = n_0$ (7a)

и граничном условии $t \geq 0$, $x = 0$, $u(R, t) = 0$ (7б)

имеет вид:

$$u = n_0 \left\{ 1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\frac{x}{\sqrt{4D_a t}}} \exp \left[-\xi^2 \right] d\xi \right\}. \quad (8)$$

Умножая (1) на $2\pi r dr$ и интегрируя по r от 0 до R , получим:

$$\frac{\partial N}{\partial t} = ZN + 2\pi r D_a \frac{\partial n_e}{\partial t} \Big|_{r=R}, \quad \text{где } N = \int_0^R 2\pi r n dr. \quad (9)$$

Подставляя (8) в (2) и дифференцируя результат по x , из (9) найдём:

$$\frac{\partial N}{\partial t} = ZN - \sqrt{\frac{4\pi D_a}{t}} R n_0 \exp \left[\int_0^t Z dt \right]. \quad (10)$$

Интегрируя (10), получим:

$$N = N_0 \exp \left[\int_0^t Z dt \right] \left\{ 1 - \frac{2\sqrt{4\pi D_a}}{\pi R} \sqrt{t} \right\} \approx N_0 \exp \int_0^t Z dt - \frac{2\sqrt{4\pi D_a}}{\pi R} \sqrt{t} \quad (11)$$

$$\frac{\partial N}{\partial t} = \left(Z - \frac{\sqrt{4\pi D_a}}{\pi R} \frac{1}{\sqrt{t}} \right) N. \quad (12)$$

Уравнения (5), (6), (11) и (12) позволяют установить ход n_e и T_e на протяжении импульсного разряда по экспериментально найденным значениям $\frac{1}{n_e} \frac{\partial n_e}{\partial t}$, если известны функции $Z(T_e)$ и $D_a(T_e)$. Эти функции могут быть вычислены в предположении максвелловского распределения электронов по скоростям по равенствам:

$$Z(T_e) = 9 \cdot 10^7 \text{ ар} \exp \left[- \frac{e v_i}{k T_e} \right] \left(\frac{k T_e}{e} \right)^{1/2} v_i \quad (13)$$

$$D_a = \mu^+ \frac{k T_e}{e}, \quad (14)$$

где a — постоянная, v_i — потенциал ионизации, $\frac{k T_e}{e}$ — выражено в вольтах, а p — в мм рт.ст.; μ^+ — подвижность ионов³.

В качестве примера рассмотрим импульсный разряд в трубке ($l = 230$ см; $d = 1,5$ см), наполненной азотом ($p = 0,75$ мм рт.ст.), который исследовался в⁴. В начальной стадии нарастания тока в условиях экспериментов⁴ $n_e = 10^{12}$ см⁻³, а T_e , как будет показано ниже, ~ 40000 °К. Оценки, выполненные по данным⁵ для ука-

занных n_e и T_e , приводят к времени релаксации рас-
 пределения скоростей электронов за счёт парных со-
 ударений $\sim 10^{-8}$ сек и, следовательно, для расчётов $Z(T_e)$
 и $D_a(T_e)$ допустимо пользоваться (13) и (14).

Кривые зависимости скоростей ионизации и диффу-
 зионных потерь от электронной температуры для боль-
 ших ($t > R^2/D_a$) и малых ($t = 10^{-6}$ и 10^{-7} сек)
 времён, вычисленные для рассматриваемого разряда,
 приведены на рис. 1. Из них видно, что скорость диф-
 фузионных потерь заряженных частиц возрастает с
 уменьшением времени. Для времён $\sim 10^{-6}$ сек она близка
 к скорости потерь при больших временах. Поэтому для
 $t \geq 10^{-6}$ сек будет использована кривая 1 рис. 1.

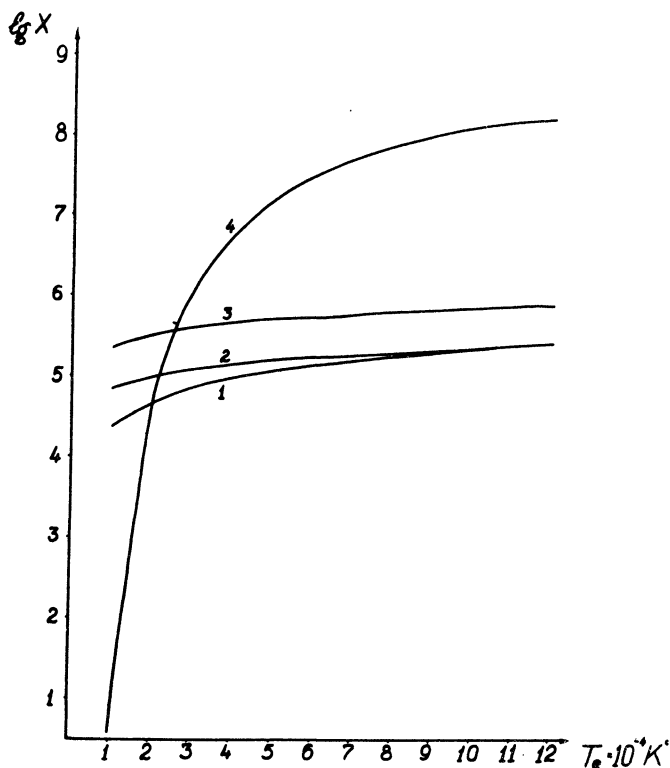
Значения $\frac{1}{n_e} \frac{\partial n_e}{\partial t}$ вычислялись по кривым $j(t)$
 и $E(t)$, согласно равенству:

$$\frac{1}{n_e} \frac{\partial n_e}{\partial t} = \frac{1}{j} \frac{\partial j}{\partial t} + \frac{1}{E} \frac{\partial E}{\partial t} \quad (15)$$

Функции $j(t)$ и $E(t)$, полученные по дан-
 ным⁴, использовались при вычислении $n_e(t)$ и $T_e(t)$
 по формулам (5) и (6). Результаты приведены на рис.
 2. Постоянная A в (5) определялась из условия $n_e =$
 $= 3 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-3}$ при $t = 0,8 \cdot 10^{-6}$ сек⁴.

Следует отметить, что (13) не учитывает ступен-
 чатую ионизацию, а её учёт привёл бы к более быст-
 рому спаду T_e , так как в начале импульсного разряда
 при относительно малых n_e и высоких T_e удель-
 ный вес ступенчатых процессов меньше, чем в более
 поздние моменты времени.

Представляет интерес найти функции $Z(E/p)$ и $T_e(E/p)$.
 Это можно сделать, исходя из данных⁴, где показано,
 что на начальном участке импульса тока n_e нара-
 стает экспоненциально с показателем экспоненты γt
 и установлена зависимость $\gamma(E/p)$.

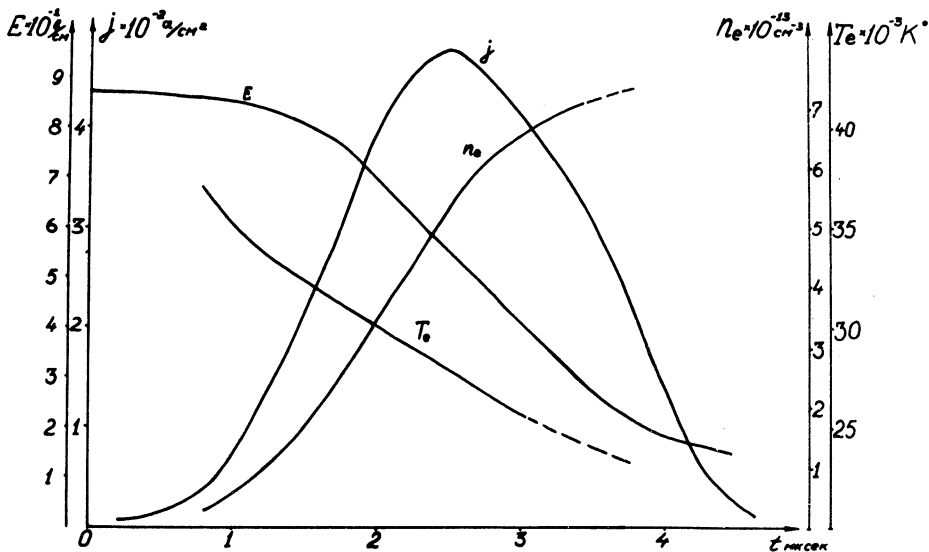


Р и с. 1. Кривые зависимости скоростей ионизации и диффузионных потерь от электронной температуры для разрядной трубки диаметром 1,5 см, наполненной азотом до давления 0,75 мм рт. ст.

1. для $t > R^2/D_a$ $X = \left(\frac{2,4}{R}\right)^2 D_a$;
2. для $t = 10^{-6}$ сек $X = 1,5 \sqrt{\frac{D_a}{t}}$;
3. для $t = 10^{-7}$ сек $X = 1,5 \sqrt{\frac{D_a}{t}}$;
4. $X = Z$

Начальный участок тока характеризуется высокой напряжённостью поля в трубке при малом разрядном токе, поэтому (5) может быть представлено в виде:

$n_e = Ve^{Zt}$. Таким образом $\gamma(E/p)$, найденные в⁴, суть

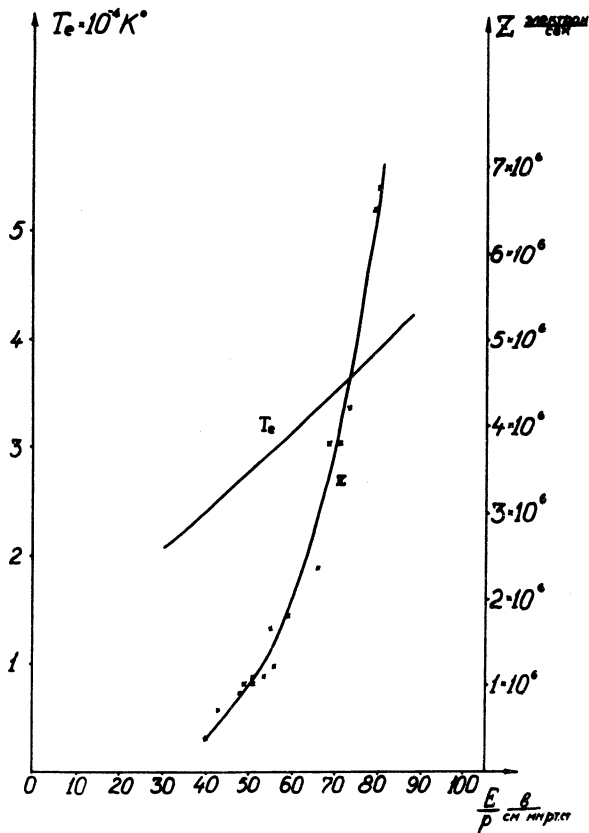


Р и с. 2. Зависимость j, E, n_e и T_e от времени на протяжении импульсного разряда.

$Z(E/p)$. Кривые $Z(E/p)$ и $T_e(E/p)$ построенные по данным⁴, приведены на рис. 3.

2. Полученная временная зависимость $n_e(t)$ и $T_e(t)$ для импульсного разряда в азоте может быть распространена и на разряды в других газах. Вероятно, для известных импульсных ОКГ (полосы $N_2(1+)$, полосы $N_2(2+)$, полосы Ангстрема молекулы CO и полосы водорода) срыв генерации и спонтанного излучения во время токового импульса связан со спадом T_e . В некоторых случаях, например, для полос $N_2(1+)$, для срыва генерации может оказаться существенным

медленное обеднение нижнего состояния. Учитывая быстрый рост плотности заряженных частиц в импульсном разряде, следует признать возможным, что в некоторых системах для срыва генерации и спонтанного излучения



Р и с. 3. Зависимость Z и T_e от E/p .

важны "сверхупругие" соударения возбуждённых частиц с электронами⁴.

Представляет интерес рассмотреть генерацию на полосах (0,0), (1,0) и (0,1) системы $N_2(2+)(C^3\Pi_u \rightarrow V^3\Pi_g)$ ⁶.

Оценки, проведённые по известным⁷ сечениям возбуждения колебательных уровней $C^3\Pi_u(v=1)$ и $V^3\Pi_g(v=0)$, показывают, что для преимущественного заселения верхнего $C^3\Pi_u(v=1)$ состояния необходима $T_e \geq \geq 100000^\circ\text{K}$. Известно, что генерация на полосах $N_2(2+)$ получается при очень высоких напряжениях. Например, в⁶ она получалась при напряжении на трубке ~ 40 кв и длине ~ 100 см. При этом E/p может достигать величины ~ 400 в/см мм рт. ст. Согласно⁴, при $\frac{E}{p} = 150$ в/см мм рт. ст. имеем $\gamma = 5 \cdot 10^7$, что соответствует $T_e = 70000^\circ\text{K}$. Естественно при $\frac{E}{p} = 400$ в/см мм рт. ст. электронная температура будет ещё больше (см. рис. 3), что и ведёт к инверсии на $C^3\Pi_u \rightarrow V^3\Pi_g$ переходе N_2 в начальной стадии импульсного разряда.

Поступила в редакцию
1 декабря 1969 г.

Л и т е р а т у р а

1. Туницкий Л. Н., Черкасов Е. М. ЖТФ, 39, 2173, (1969).
2. Westberg R.Y. Phys. Rev. 114, 1 (1959).
3. Энгель А., Ионизованные газы, Физматгиз 1959 г.
4. Князев И. Н. Диссертация, ФИАН 1968 г.
5. Грановский В. Л. "Электрический ток в газах" т.1 ГИТТЛ 1952 г.
6. Каслин В. Н., Петраш Г. Г. ЖЭТФ, 54, 1081 (1968).
7. Скубенич В. В. Диссертация, Харьковский Гос. Университет, 1969 г.